

等离子体化学气相沉积镀膜设备

Plasma Enhanced Chemical Vapor
Deposition Coating Equipment

PECVD-300、PECVD-400



中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司设备

中国科学院微电子研究所设备

主要技术与性能指标

- 中央传输室极限压力： $\leq 2 \times 10^{-4}$ Pa
- 进出片室极限压力： $\leq 6.67 \times 10^{-1}$ Pa
- 沉积室极限压力： $\leq 2 \times 10^{-6}$ Pa

主要应用

沉积碳化硅、非晶硅和微晶硅薄膜

代表性应用成果

用于制备非晶硅和微晶硅薄膜太阳能电池器件

主要用户单位	辽宁（锦州）光伏研究院、中国科学院物理研究所、斯威本科技大学、广州市中普电子有限公司、上海理工大学、创隆实业（深圳）有限公司、澳大利亚墨尔本大学、深圳大学		
研制单位	中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司		
联系方式	何 萌 010-82995592, 13581817539 万向明 024-23826819, 13998191237	hemeng@ime.ac.cn wanxm@sky.ac.cn	